



(19)

(11) Publication number:

11008355 A

Generated Document.

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 09158556

(51) Intl. Cl.: H01L 27/10 H01L 27/108 H01L 21/8242  
H01L 21/8247 H01L 29/788 H01L 29/792

(22) Application date: 16.06.97

(30) Priority:

(43) Date of application  
publication: 12.01.99(84) Designated  
contracting states:

(71) Applicant: NEC CORP

(72) Inventor: TANABE NOBUHIRO

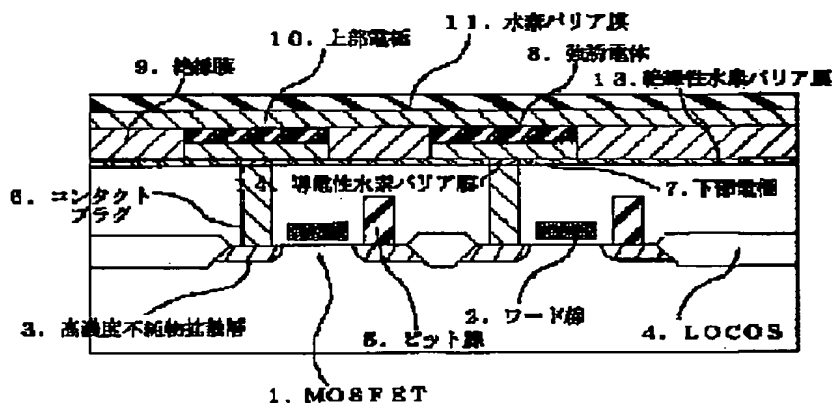
(74) Representative:

(54) FERROELECTRIC  
MEMORY

(57) Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To prevent deterioration of a ferroelectric capacitor due to hydrogen by inserting a ferroelectric film between lower and upper electrodes to laminate a first hydrogen-barrier film, ferroelectric capacitor and 2 hydrogen-barrier film.

**SOLUTION:** This memory has an insulative hydrogen-barrier film 13 formed beneath a lower electrode 7 of a ferroelectric capacitor, conductive barrier film 14 which avoids reacting the lower electrode with a contact plug and serves as an hydrogen-barrier and is formed between this plug 6 and lower electrode 7, ferroelectric film 8 formed on the lower electrode 7 with an insulation film 9 filled between each lower electrode 7 and ferroelectric film 8, upper electrode 10 of the capacitor formed on the ferroelectric film 8 and insulation film 9 to cover the entire memory array, and hydrogen-barrier film 2 formed thereon. These films 13, 14, 11 are formed by the CVD, etc.



COPYRIGHT: (C)1999,JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-8355

(43) 公開日 平成11年(1999) 1月12日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

H 0 1 L 27/10  
27/108  
21/8242  
21/8247  
29/788

識別記号

4 5 1

F I

H 0 1 L 27/10

29/78

4 5 1

6 5 1

3 7 1

審査請求 有 請求項の数 5 O L (全 6 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平9-158556

(22) 出願日 平成9年(1997) 6月16日

(71) 出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72) 発明者 田辺 伸広

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

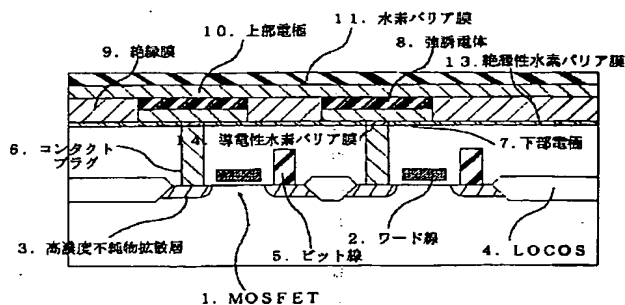
(74) 代理人 弁理士 若林 忠

(54) 【発明の名称】 強誘電体メモリ

(57) 【要約】

【課題】 強誘電体への水素侵入を防ぐためのバリア膜を用いて、強誘電体容量の横や上からだけでなく、下からの水素侵入も防ぐことにより、水素による強誘電体キャパシタの劣化に起因する誤動作を防止する。

【解決手段】 強誘電体キャパシタの上部電極10の上部に水素バリア膜11を形成し、下部電極7の下部には導電性水素バリア膜14および絶縁性水素バリア膜13を形成する。下部電極7は前記導電性水素バリア膜を介して前記コンタクトプラグ6と接続する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体基板と該半導体基板上に設けられた強誘電体キャパシタとを有し、前記強誘電体キャパシタは、下部電極と、上部電極と、該上部電極および該下部電極の間に挟まれた強誘電体膜を含む強誘電体メモリにおいて、前記半導体基板上に、第一の水素バリア膜、前記強誘電体キャパシタおよび第二の水素バリア膜をこの順に備えたことを特徴とする強誘電体メモリ。

【請求項2】 半導体基板と、該半導体基板上に設けられたメモリセルトランジスタと、該メモリセルトランジスタの上部に形成された強誘電体キャパシタとを有し、該強誘電体キャパシタと該メモリセルトランジスタとがコンタクトプラグにより接続され、前記強誘電体キャパシタは、下部電極と、上部電極と、該上部電極および該下部電極の間に挟まれた強誘電体膜を含む強誘電体メモリにおいて、前記半導体基板上に、第一の水素バリア膜、前記強誘電体キャパシタおよび第二の水素バリア膜をこの順に備え、前記第一の水素バリア膜の所定の部分が導電性水素バリア膜であり他の部分が絶縁性水素バリア膜であって、前記下部電極が前記導電性水素バリア膜を介して前記コンタクトプラグと接続されたことを特徴とする強誘電体メモリ。

【請求項3】 前記導電性水素バリア膜がTiN膜である請求項2に記載の強誘電体メモリ。

【請求項4】 前記半導体基板上に前記強誘電体キャパシタを複数有し、隣接する前記強誘電体キャパシタが前記強誘電体膜によって電気的に絶縁された請求項1乃至3いずれかに記載の強誘電体メモリ。

【請求項5】 前記第一の水素バリア膜および前記第二の水素バリア膜が、 $\text{Si}_3\text{N}_4$ 、TiN、 $\text{TiO}_2$ またはTiONを含む膜である請求項1乃至4いずれかに記載の強誘電体メモリ。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は強誘電体メモリに関し、特に半導体基板上に形成された記憶を保持するための強誘電体キャパシタとスイッチングトランジスタとでメモリセルが構成される強誘電体メモリに関する。

## 【0002】

【従来の技術】 従来、強誘電体メモリでは、たとえば特開平4-102367号公報に示されるように、水素バリア膜を用いることによって、製造工程中の強誘電体キャパシタの特性劣化を防ぐ工夫がなされている。

【0003】 図4は、特開平4-102367に示されている、製造工程中の強誘電体キャパシタの特性劣化を防ぐ方法の一例を示す断面図である。

【0004】 p型シリコン基板101上に、ゲート絶縁膜102と多結晶シリコン・ゲート103と高濃度n型領域であるソース・ドレイン領域104、105から成るMOSFET、およびMOSのアクティブ領域を区画

形成するための厚い酸化膜のLOCOS（局所酸化膜）106が形成されている。そして、LOCOS106上に層間絶縁膜107を挟んで、下部電極108、強誘電体膜109、および上部電極110から成る強誘電体キャパシタが形成されている。下部電極108、上部電極110はそれぞれアルミ配線112a、112bによって、トランジスタまたはパッド部へと接続されている。その上に層間絶縁膜113を挟んで水素バリア膜114が形成されている。水素バリア膜としてTiONのような絶縁膜を用いる場合には、層間絶縁膜113は必要無い。また、図5に示した、特開平7-74313に示されている構造を用いても、製造工程中の強誘電体キャパシタ特性劣化を防ぐことができる。

【0005】 この構造では、シリコン基板201上に層間絶縁膜202が形成されており、その層間絶縁膜に形成されたコンタクトホールに埋め込まれたポリシリコン203上にバリアメタル204、高誘電率膜205が形成され、セルアレイ全体を覆うように上部電極用のAl/TiN膜206が形成されている。ここで用いられているTiNには水素バリア性があるため、高誘電率膜205を強誘電体膜に置き換えた構造を用いることにより、製造工程中の強誘電体キャパシタ特性劣化を防ぐメモリセル構造が実現する。

## 【0006】

【発明が解決しようとする課題】 しかし、上述した従来技術には以下に示すような問題点があった。

【0007】 強誘電体キャパシタの側面、および上面は水素バリアによって覆われているので、横および上からの水素の侵入により強誘電体が還元されるのを防ぐことはできるが、下からの水素の侵入を防ぐことはできない。特に、トランジスタのしきい値電圧のばらつきを抑えるために行われる水素中での熱処理工程の際は、強誘電体キャパシタの下に形成されているトランジスタに水素を到達させるため、水素が下から侵入する可能性が高い。

【0008】 本発明の目的は、強誘電体キャパシタ下側からの水素侵入を防ぐためのバリア膜を用いて、水素による強誘電体キャパシタの劣化を防ぐ構造を実現し、信頼性の高い強誘電体メモリを提供することにある。

## 【0009】

【課題を解決するための手段】 上記課題を解決する本発明の強誘電体メモリは、半導体基板と該半導体基板上に設けられた強誘電体キャパシタとを有し、前記強誘電体キャパシタは、下部電極と、上部電極と、該上部電極および該下部電極の間に挟まれた強誘電体膜を含む強誘電体メモリにおいて、第一の水素バリア膜、前記強誘電体キャパシタおよび第二の水素バリア膜をこの順に備えたことを特徴とする。

【0010】 また、本発明の強誘電体メモリは、半導体基板と、該半導体基板上に設けられたメモリセルトラン

## 3

ジスタと、該メモリセルトランジスタの上部に形成された強誘電体キャパシタとを有し、該強誘電体キャパシタと該メモリセルトランジスタとがコンタクトプラグにより接続され、前記強誘電体キャパシタは、下部電極と、上部電極と、該上部電極および該下部電極の間に挟まれた強誘電体膜とを含む強誘電体メモリにおいて、前記半導体基板上に、第一の水素バリア膜、前記強誘電体キャパシタおよび第二の水素バリア膜をこの順に備え、前記第一の水素バリア膜の所定の部分が導電性水素バリア膜であり他の部分が絶縁性水素バリア膜であって、前記下部電極が前記導電性水素バリア膜を介して前記コンタクトプラグと接続されたことを特徴とする。

【0011】本発明の強誘電体メモリは、各メモリセルに共通な強誘電体キャパシタ上部電極（図1の10）、その上にメモリセルアレイ全体を覆うように形成されている水素バリア膜（図1の11）、強誘電体キャパシタ下部電極とコンタクトプラグとの間に形成されている導電性水素バリア膜（図1の14）、および強誘電体キャパシタ下部電極層の直下でコンタクトプラグ上を除くメモリセルアレイ部全体に形成された絶縁性水素バリア膜（図1の13）とを有する。上部電極上に形成された水素バリア膜によって、強誘電体キャパシタの横と上からの水素侵入を防ぎ、導電性バリア膜および絶縁性バリア膜によって、下からの水素侵入を防ぐことにより、水素による強誘電体キャパシタの劣化を防ぐ構造を実現している。

## 【0012】

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。

【0013】図1を参照すると、半導体基板上にメモリセルトランジスタとして用いるMOSFET1が形成され、それぞれのMOSFETはLOCOS4によって電気的に分離されている。MOSFETのゲート電極はワード線2として用い、一方の高濃度不純物拡散層3にはビット線5が接続されている。もう一方の高濃度不純物拡散層にはコンタクトプラグ6を介して強誘電体キャパシタの下部電極7に接続されている。下部電極7の直下には絶縁性水素バリア膜13が形成され、コンタクトプラグ6と下部電極7との間には、下部電極とコンタクトプラグとの反応を防ぎ、かつ水素バリアにもなる導電性バリア膜14が形成されている。図1には、コンタクトプラグ6の上のみに導電性バリア膜14が形成されているように描かれているが、異なる下部電極7同士が短絡しない範囲であれば、導電性バリア膜14を広げても良い。下部電極7上には強誘電体薄膜8が形成され、各下部電極7および強誘電体薄膜8の間は絶縁膜9で埋められている。図1には、強誘電体薄膜8の表面と絶縁膜9の表面が同じ高さになっているように描かれているが、絶縁膜9の表面の高さは下部電極7よりも高ければ、強誘電体薄膜8の表面より低くても良い。強誘電体薄膜8

## 4

および絶縁膜9の上にはメモリセルアレイ全体を覆うように強誘電体キャパシタの上部電極10が形成され、その上には水素バリア膜11が形成されている。

【0014】絶縁性水素バリア膜13、導電性バリア膜14および水素バリア膜11は、それぞれCVD法、スパッタ法等により形成される。これらの膜の厚みは、膜の種類、性質等にもよるが、好ましくは1000～5000Å、さらに好ましくは2000～3000Åとする。1000Å未満では水素バリア性が不足する場合があります。5000Åを越える膜厚としても通常はそれ以上の効果が望めないからである。導電性バリア膜14は、強誘電体キャパシタと、これに対応するメモリセルトランジスタとの導通が保たれる範囲の導電性を有する。一方、絶縁性水素バリア膜13は、強誘電体キャパシタと、これに隣接する強誘電体キャパシタおよびこれに接続するコンタクトプラグとの絶縁性が保たれる範囲の絶縁性を有する。

【0015】次に、本発明の第2の実施の形態について図面を参照して説明する。図2を参照すると、半導体基板上にメモリセルトランジスタとして用いるMOSFET1が形成され、それぞれのMOSFETはLOCOS4によって電気的に分離されている。MOSFETのゲート電極はワード線2として用い、一方の高濃度不純物拡散層3にはビット線5が接続されている。もう一方の高濃度不純物拡散層にはコンタクトプラグ6を介して強誘電体キャパシタの下部電極7に接続されている。下部電極7の直下には水素バリア用の絶縁膜13が形成され、コンタクトプラグ6と下部電極7との間には、下部電極とコンタクトプラグとの反応を防ぎ、かつ水素バリアにもなる導電性バリア膜14が形成されている。図2には、コンタクトプラグ6の上のみに導電性バリア膜14が形成されているように描かれているが、異なる下部電極7同士が短絡しない範囲であれば、導電性バリア膜14を広げても良い。下部電極7上には強誘電体薄膜8が形成され、それらを覆うように絶縁膜9が形成されている。絶縁膜9にはそれぞれの強誘電体薄膜8に対してコンタクト孔12が開けられ、その上にメモリセルアレイ全体を覆うように強誘電体キャパシタの上部電極10が形成され、その上には水素バリア膜11が形成されている。

【0016】次に、本発明の第3の実施の形態について図面を参照して説明する。図3を参照すると、半導体基板上にメモリセルトランジスタとして用いるMOSFET1が形成され、それぞれのMOSFETはLOCOS4によって電気的に分離されている。MOSFETのゲート電極はワード線2として用い、一方の高濃度不純物拡散層3にはビット線5が接続されている。もう一方の高濃度不純物拡散層にはコンタクトプラグ6を介して強誘電体キャパシタの下部電極7に接続されている。下部電極7の直下には水素バリア用の絶縁膜13が形成さ

5

れ、コンタクトプラグ6と下部電極7との間には、下部電極とコンタクトプラグとの反応を防ぎ、かつ水素バリアにもなる導電性バリア膜14が形成されている。図3には、コンタクトプラグ6の上のみに導電性バリア膜14が形成されているように描かれているが、異なる下部電極7同士が短絡しない範囲であれば、導電性バリア膜14を広げても良い。下部電極7上にはメモリセルアレイ全体を覆うように強誘電体薄膜8が形成され、その上に強誘電体キャパシタの上部電極10が形成され、その上には水素バリア膜11が形成されている。隣接する強誘電体キャパシタは、強誘電体膜8によって電氣的に絶縁されている。

【0017】本発明の第3の実施の形態は、強誘電体薄膜の微細加工を行わず、また、絶縁膜9を成膜しないことから、第1の実施の形態の効果に加えて、工程削減および工程の簡易化の効果も有する。

【0018】なお、強誘電体キャパシタとメモリセルトランジスタとの接続は、上記の実施形態においてはコンタクトプラグにより接続方式の例を示したが、これに限定されるものではなく、Al合金等の配線材により接続する方式であってもよい。また、上記の実施形態ではメモリセルトランジスタは強誘電体キャパシタの下部電極と接続しているが、上部電極と接続する形態であってもよい。

【実施例】次に、本発明の第1の実施例について図面を参照して説明する。図1を参照すると、半導体基板上にメモリセルトランジスタとして用いるMOSFET1が形成され、それぞれのMOSFETはLOCOS4によって電氣的に分離されている。ポリシリコン、またはポリシリコンとWSiあるいはTiSiあるいはCoSi等のシリサイドとの積層構造であるいわゆるポリサイドによって形成されているMOSFETのゲート電極はワード線2として用い、一方の高濃度不純物拡散層3にはビット線5が接続されている。ビット線5の材料としては、耐熱性が高く、かつ基板に形成された接合間のリーク特性を劣化させないWSi等を用いる。もう一方の高濃度不純物拡散層にはポリシリコンまたはWで形成されたコンタクトプラグ6を介して強誘電体キャパシタの下部電極7に接続されている。下部電極7の材料としては、耐酸化性の強いPtや酸化物が導電性であるRu、Irまたはそれらの酸化物であるRuO<sub>2</sub>、IrO<sub>2</sub>を用いる。下部電極7の直下にはSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>、TiO<sub>2</sub>等の水素バリア用の絶縁膜13が形成され、コンタクトプラグ6と下部電極7との間には、下部電極とコンタクトプラグとの反応を防ぎ、かつ水素バリアにもなる導電性バリア膜14が形成されている。導電性バリア膜14としては酸素含有率の少ないTiONまたはTiNを用いることができ、好ましくはTiNを用いる。図1には、コンタクトプラグ6の上のみに導電性バリア膜14が形成されているように描かれているが、異なる下部電極7同士が

6

短絡しない範囲であれば、導電性バリア膜14を広げても良い。下部電極7上にはPZT(PbZr<sub>x</sub>Ti<sub>1-x</sub>O<sub>3</sub>)、SBT(SrBi<sub>2</sub>Ta<sub>2</sub>O<sub>9</sub>)等の強誘電体薄膜8が形成され、各下部電極7および強誘電体薄膜8の間はSiO<sub>2</sub>、Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>、SiON等の絶縁膜9で埋められている。図1には、強誘電体薄膜8の表面と絶縁膜9の表面が同じ高さになっているように描かれているが、絶縁膜9の表面の高さは下部電極7よりも高ければ、強誘電体薄膜8の表面より低くても良い。強誘電体薄膜8および絶縁膜9の上にはメモリセルアレイ全体を覆うように強誘電体キャパシタの上部電極10が形成され、その上には水素バリア膜11が形成されている。なお、水素バリア膜11の被覆範囲は、図では基板全面にわたっているが、少なくとも誘電体キャパシタを覆う範囲であればよい。上部電極材料としては、下部電極材料として挙げたPt、Ru、Ir、RuO<sub>2</sub>、IrO<sub>2</sub>等を用いる。また水素バリア膜としては、TiN、TiO<sub>2</sub>、TiONまたはSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>を用いる。

【0019】次に、本発明の第2の実施例について図面を参照して説明する。図2を参照すると、半導体基板上にメモリセルトランジスタとして用いるMOSFET1が形成され、それぞれのMOSFETはLOCOS4によって電氣的に分離されている。ポリシリコン、またはポリシリコンとWSiあるいはTiSiあるいはCoSi等のシリサイドとの積層構造であるいわゆるポリサイドによって形成されているMOSFETのゲート電極はワード線2として用い、一方の高濃度不純物拡散層3にはビット線5が接続されている。ビット線5の材料としては、耐熱性が高く、かつ基板に形成された接合間のリーク特性を劣化させないWSi等を用いる。もう一方の高濃度不純物拡散層にはポリシリコンまたはWで形成されたコンタクトプラグ6を介して強誘電体キャパシタの下部電極7に接続されている。下部電極7の材料としては、耐酸化性の強いPtや酸化物が導電性であるRu、Irまたはそれらの酸化物であるRuO<sub>2</sub>、IrO<sub>2</sub>を用いる。下部電極7の直下にはSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>、TiO<sub>2</sub>等の水素バリア用の絶縁膜13が形成され、コンタクトプラグ6と下部電極7との間には、下部電極とコンタクトプラグとの反応を防ぎ、かつ水素バリアにもなる導電性バリア膜14が形成されている。導電性バリア膜14としてはTiNを用いる。図2には、コンタクトプラグ6の上のみに導電性バリア膜14が形成されているように描かれているが、異なる下部電極7同士が短絡しない範囲であれば、導電性バリア膜14を広げても良い。下部電極7上にはPZT、SBT等の強誘電体薄膜8が形成され、それらを覆うようにSiO<sub>2</sub>、Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>、SiON等の絶縁膜9が形成されている。絶縁膜9にはそれぞれの強誘電体薄膜8に対してコンタクト穴12が開けられ、その上にメモリセルアレイ全体を覆うように強誘電体キャパシタの上部電極10が形成され、その上には水素バ

ア膜11が形成されている。上部電極材料としては、下部電極材料として挙げたPt、Ru、Ir、RuO<sub>2</sub>、IrO<sub>2</sub>等を用いる。また水素バリア膜としては、TiN、TiO<sub>2</sub>、TiONまたはSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>を用いる。

【0020】次に、本発明の第3の実施例について図面を参照して説明する。

【0021】図3を参照すると、半導体基板上にメモリセルトランジスタとして用いるMOSFET1が形成され、それぞれのMOSFETはLOCOS4によって電氣的に分離されている。ポリシリコン、またはポリシリコンとWSiあるいはTisiあるいはCosi等のシリサイドとの積層構造であるいわゆるポリサイドによって形成されているMOSFETのゲート電極はワード線2として用い、一方の高濃度不純物拡散層3にはビット線5が接続されている。ビット線5の材料としては、耐熱性が高く、かつ基板に形成された接合間のリーク特性を劣化させないWSi等を用いる。もう一方の高濃度不純物拡散層にはポリシリコンまたはWで形成されたコンタクトプラグ6を介して強誘電体キャパシタの下部電極7に接続されている。下部電極7の材料としては、耐酸化性の強いPtや酸化物が導電性であるRu、Irまたそれらの酸化物であるRuO<sub>2</sub>、IrO<sub>2</sub>を用いる。下部電極7の直下にはSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>、TiO<sub>2</sub>等の水素バリア用の絶縁膜13が形成され、コンタクトプラグ6と下部電極7との間には、下部電極とコンタクトプラグとの反応を防ぎ、かつ水素バリアにもなる導電性バリア膜14が形成されている。導電性バリア膜14としてはTiNを用いる。図3には、コンタクトプラグ6の上のみに導電性バリア膜14が形成されているように描かれているが、異なる下部電極7同士が短絡しない範囲であれば、導電性バリア膜14を広げても良い。下部電極7上にはメモリセルアレイ全体を覆うようにPZT、SBT等の強誘電体薄膜8が形成され、その上に強誘電体キャパシタの上部電極10が形成され、その上には水素バリア膜11が形成されている。隣接する強誘電体キャパシタは、強誘電体膜8によって電氣的に絶縁されている。上部電極材料としては、下部電極材料として挙げたPt、Ru、Ir、RuO<sub>2</sub>、IrO<sub>2</sub>等を用いる。また水素バリア膜としては、TiN、TiO<sub>2</sub>、TiONまたはSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>を用いる。

【0022】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の強誘電体キャパシタは以下に示す効果を有する。

【0023】第1の効果は、強誘電体キャパシタの下側からの水素の侵入を防ぐことができるということである。

【0024】その理由は、強誘電体キャパシタを形成する下地の絶縁膜に水素バリア膜を用い、かつ下部電極とプラグ電極との間に水素バリア膜を用いることにより、強誘電体キャパシタの下側が完全に水素バリア膜によ

て覆われるからである。

【0025】第2の効果は、強誘電体メモリ作製工程の削減および工程の簡易化を図ることができることである。

【0026】その理由は、強誘電体によって下部電極と上部電極を電氣的に分離しているため、分離用の絶縁膜を形成する工程を必要とせず、また、強誘電体を下部電極と等しいかまたはほぼ等しい大きさに微細加工する必要が無いからである。

# 10 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態を示す断面図である。

【図2】本発明の第2の実施の形態を示す断面図である。

【図3】本発明の第3の実施の形態を示す断面図である。

【図4】第1の従来例を示す断面図である。

【図5】第2の従来例を示す断面図である。

## 【符号の説明】

- |     |             |
|-----|-------------|
| 1   | MOSFET      |
| 2   | ワード線        |
| 3   | 高濃度不純物拡散層   |
| 4   | LOCOS       |
| 5   | ビット線        |
| 6   | コンタクトプラグ    |
| 7   | 下部電極        |
| 8   | 強誘電体        |
| 9   | 絶縁膜         |
| 10  | 上部電極        |
| 11  | 水素バリア膜      |
| 12  | コンタクト孔      |
| 13  | 絶縁性水素バリア膜   |
| 14  | 導電性水素バリア膜   |
| 101 | p型シリコン基板    |
| 102 | ゲート絶縁膜      |
| 103 | 多結晶シリコン・ゲート |
| 104 | ソース・ドレイン領域  |
| 105 | ソース・ドレイン領域  |
| 106 | LOCOS       |
| 107 | 層間絶縁膜       |
| 108 | 下部電極        |
| 109 | 強誘電体膜       |
| 110 | 上部電極        |
| 111 | 層間絶縁膜       |
| 112 | アルミ配線       |
| 113 | 層間絶縁膜       |
| 114 | 水素バリア膜      |
| 201 | シリコン基板      |
| 202 | 層間絶縁膜       |
| 203 | ポリシリコン      |

9

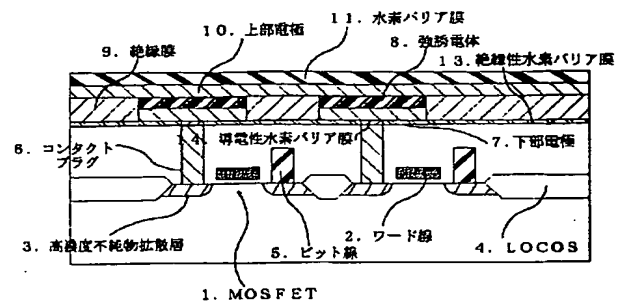
10

204 バリアメタル

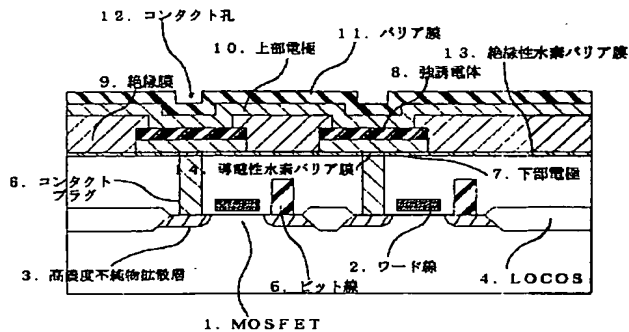
206 上部電極Al/TiN膜

205 高誘電率膜

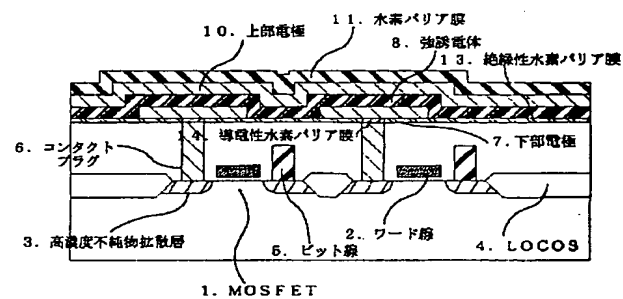
【図1】



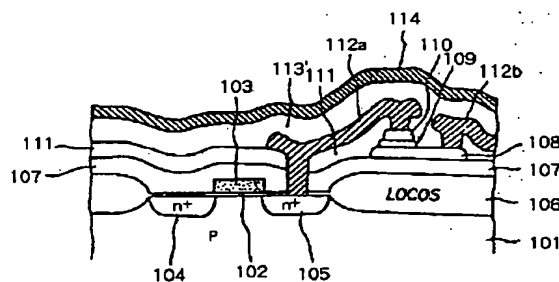
【図2】



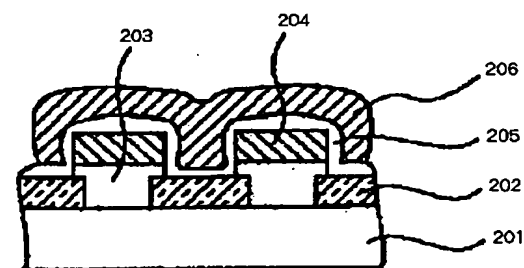
【図3】



【図4】



【図5】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号

F I

H01L 29/792